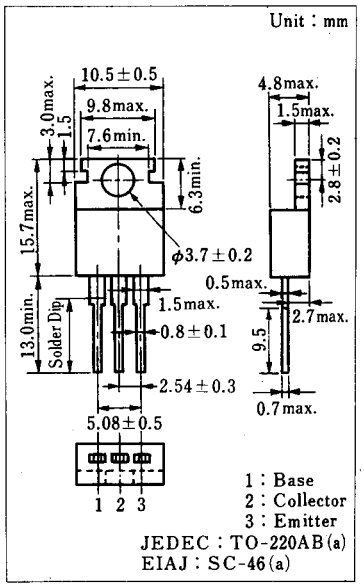
2SD762, 2SD762A

シリコン NPN 三重拡散接合形／Si NPN Triple Diffused Junction

低周波電力増幅用／AF Power Amplifier



■ 特　徴／Feature

- 安全動作領域（ASO）が広い。／Wide area of safe operation (ASO)

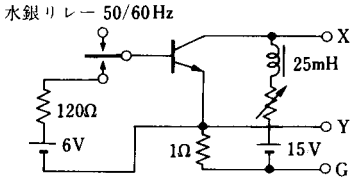
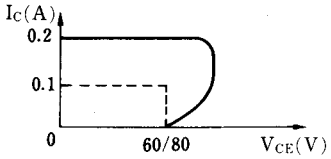
■ 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25 ℃)

Item		Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD762	V_{CBO}	60	V
	2SD762A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD762	V_{CEO}	60	V
	2SD762A		80	
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	8	V
せん頭コレクタ電流		I_{CP}	6	A
コレクタ電流		I_C	4	A
ベース電流		I_B	1	A
コレクタ損失 (Tc=25 ℃)		P_C	30	W
接合部温度		T_j	150	℃
保存温度		T_{stg}	−55～+150	℃

■ 電気的特性／Electrical Characteristics (Tc=25℃)

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流		I_{CBO}	V_{CB}=20 V, I_E=0			30	μA
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	V_{EB}=8 V, I_C=0			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	2SD762	$V_{CEO(sus)}$*2	I_C=0.2 A, L=25 mH	60			V
	2SD762A			80			V
直流電流増幅率		h_{FE1}	V_{CE}=3 V, I_C=0.1 A	40			
		h_{FE2}*1	V_{CE}=3 V, I_C=1 A	30		160	
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	V_{CE}=3 V, I_C=1 A			1.2	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	I_C=2 A, I_B=0.4 A			1	V
しゃ断周波数		$f_{\alpha e}$	V_{CE}=10 V, I_C=0.2 A		25		kHz

*1 h_{FE2}ランク分類／h_{FE2} Classifications

Class	Q	P	O
h_{FE2}	30～60	50～100	80～160

*2 $V_{CEO(sus)}$測定回路／$V_{CEO(sus)}$ Test Circuit